

а 2005 0253

Изобретение относится к полупроводниковым материалам и может быть использовано для получения полупроводниковых сплавов.

Сущность изобретения, согласно первому варианту, состоит в том, что сплав выполнен на основе Bi , допированного Te и обожженного до рекристаллизации, градиент температуры которого направлен вдоль тригональной оси кристаллической решетки сплава, где Te содержится в пропорции 1,35...1,45% ат. Согласно второму варианту, градиент температуры сплава направлен вдоль биссектрисы его кристаллической решетки, где Te содержится в пропорции 1,05...1,15% ат.

П. формулы: 2

Фиг.: 1